

LIVE ウェビナ(日本語で実施)

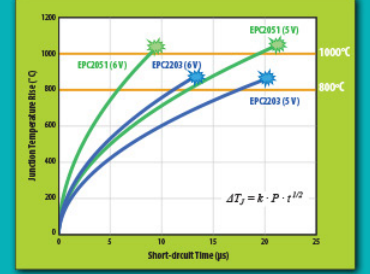
GaNがシリコン・パワーMOSFETよりも丈夫な理由を理解する

2020年11月18日 午前10時(東京時間)

発表者: 安田 昭一、日本営業部門バイス・プレジデント

ゲスト・パネリスト: Alex Lidow (アレックス・リドウ)、Ph.D.、EPCのCEO(最高経営責任者)で共同創立者

GaNの利用法
ウェビナ・シリーズ



11月18日(水)にご参加いただき、GaNパワー・デバイスの信頼性の重要な視点と、窒化ガリウムが故障するまでのテストによって、シリコン・パワーMOSFETでは並ぶものがない丈夫さどのように実証しているかをご覧ください。

このウェビナで、安田 昭一は以下の説明をします。

- 動的オン抵抗に影響する主なメカニズムを特定し、より丈夫な設計を行うことに利用する方法。
- いくつかのeGaN製品を、データシートの安全動作領域(SOA)全体にわたって、徹底的にテストし、安全マージンを調べるために故障させた方法。
- eGaNデバイスを短絡条件下で、破壊されるまでテストし、壊滅的な故障が発生する前に、どのくらいの時間、どれくらいのエネルギー密度に耐えられるかを判断する方法。
- 長期間のLidarパルス・ストレス条件で、eGaNの信頼性を評価するための専用システムを、EPCがどのように開発したか。

スペシャル・ゲスト・パネリスト: CEOのAlex Lidow(アレックス・リドウ)がウェビナ・プレゼンテーションの後のQ&Aに参加します。

すべての登録者は、書籍 *GaN Transistors for Efficient Power Conversion* の第3版のコピーを獲得するチャンスに参加できます。

今すぐ登録!



mitsuiwa

EPC
EFFICIENT POWER CONVERSION

電力変換技術のリーダー

epc-co.com/epc/jp